

(19) 日本国特許庁(JP)

再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

W02004/001819

発行日 平成17年10月27日(2005.10.27)

(43) 国際公開日 平成15年12月31日(2003.12.31)

(51) Int. Cl.⁷

H01L 21/68

H01L 21/02

F I

H01L 21/68

H01L 21/02

N

C

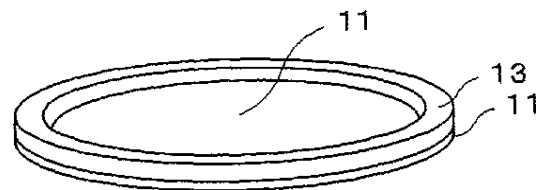
審査請求 有 予備審査請求 未請求 (全 17 頁)

出願番号	特願2004-530924 (P2004-530924)	(71) 出願人	000106276
(21) 国際出願番号	PCT/JP2003/007975		サンケン電気株式会社
(22) 国際出願日	平成15年6月24日(2003.6.24)		埼玉県新座市北野3丁目6番3号
(31) 優先権主張番号	特願2002-183939 (P2002-183939)	(74) 代理人	100095407
(32) 優先日	平成14年6月25日(2002.6.25)		弁理士 木村 満
(33) 優先権主張国	日本国(JP)	(74) 代理人	100109449
(31) 優先権主張番号	特願2002-319884 (P2002-319884)		弁理士 毛受 隆典
(32) 優先日	平成14年11月1日(2002.11.1)	(72) 発明者	三田 文章
(33) 優先権主張国	日本国(JP)		日本国埼玉県新座市北野3丁目6番3号
(81) 指定国	JP, US		サンケン電気株式会社内

(54) 【発明の名称】 半導体素子の製造方法およびリング状補強部材

(57) 【要約】

薄く加工された半導体基板(11)の一面に、例えばシリコンから構成されるリング状の補強リング(13)を固着させる。補強リング(13)は、比較的融点の低い金属、合金または比較的融点あるいは軟化点が低いポリイミド系樹脂から構成される無機接着材層(14)によって固着される。半導体基板(11)に補強リング(13)を固着させた状態で、金属膜(15)の形成処理を行う。補強リング(13)は、半導体基板11と同一の外径を有する。また、薄く加工された半導体基板(11)の厚さと補強リング(13)の厚さとを合わせた厚さは、薄く加工されていない半導体基板(11)の厚さとほぼ等しいので、補強リング(13)が固着された状態の半導体基板(11)を既存の搬送ユニット等で搬送することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

複数の半導体素子が形成された半導体基板(11)を用意し、該半導体基板(11)を薄くする第1の工程と、

前記半導体基板(11)の一面に、該一面の一部を露出する補強部材(13)を接着部材によって固着させる第2の工程と、

前記半導体基板(11)の一面の露出部分または該半導体基板(11)の他面に、前記半導体素子が備える電極を構成するための金属膜(15)を形成する第3の工程と、

前記補強部材(13)を前記半導体基板(11)から除去し、該半導体基板(11)をダイシングする第4の工程と、

を含んでおり、

前記接着部材(13、25)は、状態が前記第3の工程における処理温度よりも高い温度で変化する材料から構成されている、

ことを特徴とする半導体素子の製造方法。

【請求項 2】

前記補強部材(13)は、中心に開口を有し、前記半導体基板(11)の外径と等しい外径を有するリング状の形状を有し、

前記第2の工程は、該半導体基板(11)の外周縁と該リング状の補強部材(13)の外周縁とを合わせて該半導体基板(11)の一面に該補強部材(13)を前記接着部材によって固着し、

前記第3の工程は、前記リング状の補強部材(13)の開口を介して露出した前記半導体基板(11)の一面に、前記金属膜(15)を形成する、

ことを特徴とする請求項1に記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 3】

前記接着部材は、前記第3の工程における処理温度よりも高い融点を有する金属あるいは合金、または前記第3の工程における処理温度よりも高い融点あるいは軟化点を有する耐熱性樹脂から構成されることを特徴とする請求項1に記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 4】

前記耐熱性樹脂は、ポリイミド系樹脂である、ことを特徴とする請求項3に記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 5】

前記第2の工程では、

前記リング状の補強部材(13)の一面に前記接着部材の層(14、25)を形成し、

前記リング状の補強部材(13)の一面を前記半導体基板(11)の一面に重ね、加熱によって前記リング状の補強部材(13)と前記半導体基板(11)との間に介在する前記接着部材の層(14、25)を溶融させ、

冷却によって前記接着部材の層(14、25)を固化させることにより、前記リング状の補強部材(13)を前記半導体基板(11)に固着させる、

ことを特徴とする請求項3に記載の半導体素子の製造方法。

【請求項 6】

前記第1の工程では、

用意した前記半導体基板(11)の他面に、第1のテープ状補強部材(12)を有機系接着剤によって貼り付け、前記第1のテープ状補強部材(12)を貼り付けた状態で、該半導体基板(11)の一面に薄く加工をすることにより、該半導体基板(11)を所定の厚さにまで薄くし、

前記第2の工程では、

前記第1のテープ状補強部材(12)が前記半導体基板(11)の他面に貼り付けられた状態で、該半導体基板の一面に前記リング状の補強部材(13)を接着部材の層(14)によって固着させ、

前記第3の工程では、

10

20

30

40

50

該リング状の補強部材(13)が該半導体基板(11)に固着された状態で、該半導体基板(11)から第1のテープ状補強部材(12)を除去した後に、前記金属膜(15)を該リング状補強部材(13)の開口を介して該半導体基板(11)の一面に形成する、ことを特徴とする請求項5に記載の半導体素子の製造方法。

【請求項7】

前記接着部材の層(14)は、前記第1のテープ状補強部材(12)が備える耐熱温度よりも低い融点を有することを特徴とする請求項6に記載の半導体素子の製造方法。

【請求項8】

前記第4の工程では、前記半導体基板(11)の他面に第2のテープ状補強部材(18)を貼り付け、該半導体基板(11)の一面から前記リング状の補強部材(13)を除去し、該半導体基板(11)を各半導体素子を構成するチップ(22)にダイシングする、ことをさらに特徴とする請求項6に記載の半導体素子の製造方法。

10

【請求項9】

前記接着部材の層(14)は、前記第2のテープ状補強部材(18)の耐熱温度よりも低い融点を有し、

前記第2のテープ状補強部材(18)の耐熱温度よりも低い温度の加熱によって前記接着部材の層(14)を溶融することにより、前記リング状の補強部材(13)を前記半導体基板(11)から除去する、

ことを特徴とする請求項8に記載の半導体素子の製造方法。

【請求項10】

前記第1の工程では、

用意した半導体基板(11)の他面に、第1のテープ部材(12)を有機系接着剤で貼り付け、該半導体基板(11)の一面に、薄く加工することにより、該半導体基板(11)を所定の厚さにまで薄くし、

前記第2の工程では、

前記半導体基板(11)を、ヒータを備えるステージ(24)上に固定し、該ステージ(24)上に固定された前記半導体基板(11)を加熱することにより、前記第1のテープ状補強部材(12)が有する線膨張係数と該半導体基板(11)が有する線膨張係数との差によって該半導体基板(11)に生じた反りを緩和する、

ことを特徴とする請求項3に記載の半導体素子の製造方法。

20

30

【請求項11】

所定の厚みに薄く加工された半導体基板(11)を備える半導体素子の製造工程に用いられ、

中心に開口を有し、前記半導体基板(11)の外径と等しい外径を有するリング状の形状を有し、該半導体基板(11)の一面に接着部材によって固着されることにより、薄く加工することによって低下した該半導体基板(11)の強度を補う、

ことを特徴とするリング状補強部材。

【請求項12】

薄く加工された前記半導体素子の所定の厚みよりも大きな厚みを有する、ことを特徴とする請求項11に記載のリング状補強部材。

40

【請求項13】

前記半導体基板(11)と同一の材料から構成され、該半導体基板(11)と等しい線膨張係数を有する、ことを特徴とする請求項12に記載のリング状補強部材。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

本発明は、比較的薄い半導体基板を備える半導体素子の製造方法及びこれに用いるリング状補強部材に関する。

【背景技術】

例えばパワートランジスタ等のパワー系半導体素子は、複数の半導体領域が形成されている半導体基板と、半導体基板の両面に形成された電極とを備える。

50

電子機器の小型化に伴い、パワー系半導体素子のなかには小型化、薄型化されたものがある。この種のパワー系半導体素子は、通常、厚みが比較的薄い半導体基板を備えている。

従来、薄い半導体基板を備えたパワー系半導体素子は、例えば以下に説明する手順で製造されていた。

まず、図4Aに示すように、半導体基板100を用意する。この半導体基板100の一面の表面領域には、複数の半導体領域が不純物拡散等によって形成されている。これらの複数の半導体領域によって複数の半導体素子が形成されている。また、半導体基板100の一面には、エミッタ電極やソース電極等の図示しない電極が形成されている。

次に、半導体基板100の一面に、第1の補強部材101を有機系接着剤（例えば、紫外線硬化性樹脂）で固着する。 10

続いて、半導体基板100の他面を切削またはエッチングして、半導体基板100を、図4Bに示すように薄くする。

半導体基板100を薄くすると、半導体基板100の強度が低下する。このため、半導体基板100単独では、後続する種々の工程でのハンドリングや搬送の際に、半導体基板100に割れや欠けが生じやすい。第1の補強部材101は、半導体基板100に割れや欠けが生じることを防止するためのものであり、半導体基板100に固着された状態で、半導体基板100の強度を補っている。

続いて、半導体基板100の他面にスパッタリングや真空蒸着等により、図4Cに示すように金属膜102を形成する。金属膜102をパターニングして、コレクタ電極やドレイン電極等の電極を構成する。 20

次に、図4Dに示すように、リング状のフレーム104が固着された第2の補強部材103を半導体基板100の他面に貼りつける。第2の補強部材103は、例えば、半導体基板100を個々の半導体素子チップにダイシングする際に、該各半導体素子チップを固定するためのものである。続いて、第1の補強部材101を半導体基板100から除去する。

続いて、半導体基板100は、図4Eに示すように、ダイシング刃105によって複数の半導体素子チップ106に分割される。

そして、第2の補強部材103を各半導体素子チップ106から除去する。これによって、半導体素子チップ106は、個々に分離され、ボンディング工程等の次の工程に送られる。 30

上述した従来の製造工程では、半導体基板100の一面に有機系接着剤で第1の補強部材101を固着している。

しかしながら、この手法では、半導体基板100の他面に金属膜102を形成する際に、有機系接着剤の成分が揮発して、金属膜102の形成に悪影響を与える場合がある。

例えば、 10^{-5} Pa程度の真空度かつ100～200程度の温度で、第1の補強部材101が固着された半導体基板100にスパッタリングや真空蒸着等を施すと、有機系接着剤が分解してガスが発生する。このガスのために、金属膜102の膜質が低下してしまう。

半導体基板100の強度を補うとともに、金属膜102の膜質の低下を防止するため、専用の治具によって半導体基板100を保持した状態で半導体基板100の搬送等を行うことも考えられる。しかし、専用治具を使用する場合、既存の搬送ユニット、カセット、ステージ等を使用することができず、専用治具に対応させて製造プロセスのユニットを変更しなくてはならない。 40

このように、半導体基板に割れや欠けが生じることを防止することは、様々な問題があり、従来は困難であった。

本発明は上記実状に鑑みてなされたもので、半導体基板に割れや欠けが発生することを容易に防止することができる半導体素子の製造方法及びこれに用いるリング状補強部材を提供することを目的とする。

また、本発明は、信頼性の高い電極を形成することができる半導体素子の製造方法及び 50

これに用いるリング状補強部材を提供することを目的とする。

さらに、本発明は、製造コストの増大を招くことなく半導体基板に割れや欠けが発生することを防止することができる半導体素子の製造方法及びこれに用いるリング状補強部材を提供することを目的とする。

【発明の開示】

上記目的を達成するため、本発明の第1の観点に係る半導体素子の製造方法は、複数の半導体素子が形成された半導体基板(11)を用意し、該半導体基板(11)を薄くする第1の工程と、前記半導体基板(11)の一面に、該一面の一部を露出する補強部材(13)を接着部材によって固着させる第2の工程と、

前記半導体基板(11)の一面の露出部分または該半導体基板(11)の他面に、前記半導体素子が備える電極を構成するための金属膜(15)を形成する第3の工程と、前記補強部材(13)を前記半導体基板(11)から除去し、該半導体基板(11)をダイシングする第4の工程と、を含んでおり、前記接着部材(13、25)は、状態が前記第3の工程における処理温度よりも高い温度で変化する材料から構成されている、ことを特徴とする。

このように、この製造方法では、薄く加工することによって強度が低下した半導体基板に、リング状の補強部材を固着することによって、この半導体基板に割れや欠けが発生することを防止している。外径が半導体基板と等しいリング状の補強部材を使用することにより、例えば、薄く加工された半導体基板の強度を補うための専用の治具等を使用する場合のように、専用の治具にあわせて搬送ユニットやカセットを変更する必要がない。さらに、この製造方法では、半導体基板にリング状の補強部材を固着するための接着部材に、金属膜を形成する際に加わる温度では状態変化を起こさない材料を用いている。このため、金属膜形成条件下で、接着部材が金属膜の形成に悪影響をもたらすガスを溶融によって生じさせない。これにより、信頼性の高い電極を形成することが可能となる。

前記補強部材(13)は、中心に開口を有し、前記半導体基板(11)の外径と等しい外径を有するリング状の形状を有し、前記第2の工程では、該半導体基板(11)の外周縁と該リング状の補強部材(13)の外周縁とを合わせて該半導体基板(11)の一面に該補強部材(13)を前記接着部材によって固着し、

前記第3の工程は、前記リング状の補強部材(13)の開口を介して露出した前記半導体基板(11)の一面に、前記金属膜(15)を形成する、ようにしてもよい。

前記接着部材は、前記第3の工程における処理温度よりも高い融点を有する金属あるいは合金、または前記第3の工程における処理温度よりも高い融点あるいは軟化点を有する耐熱性樹脂から構成されてもよい。

前記耐熱性樹脂は、ポリイミド系樹脂であってもよい。

前記第2の工程では、前記リング状の補強部材(13)の一面に前記接着部材の層(14、25)を形成し、前記リング状の補強部材(13)の一面を前記半導体基板(11)の一面に重ね、加熱によって前記リング状の補強部材(13)と前記半導体基板(11)との間に介在する前記接着部材の層(14、25)を溶融させ、冷却によって前記接着部材の層(14、25)を固化させることにより、前記リング状の補強部材(13)を前記半導体基板(11)に固着させる、ようにしてもよい。

前記第1の工程では、用意した前記半導体基板(11)の他面に、第1のテープ状補強部材(12)を有機系接着剤によって貼り付け、前記第1のテープ状補強部材(12)を貼り付けた状態で、該半導体基板(11)の一面に薄く加工することにより、該半導体基板(11)を所定の厚さにまで薄くし、前記第2の工程では、前記第1のテープ状補強部材(12)が前記半導体基板(11)の他面に貼り付けられた状態で、該半導体基板の一面に前記リング状の補強部材(13)を接着部材の層(14)によって固着させ、前記第3の工程では、該リング状の補強部材(13)が該半導体基板(11)に固着された状態で、該半導体基板(11)から第1のテープ状補強部材(12)を除去した後に、前記金属膜(15)を該リング状補強部材(13)の開口を介して該半導体基板(11)の一面に形成する、ようにしてもよい。

10

20

30

40

50

前記接着部材の層(14)は、前記第1のテープ状補強部材(12)が備える耐熱温度よりも低い融点を有するものであってもよい。

さらに、前記第4の工程では、前記半導体基板(11)の他面に第2のテープ状補強部材(18)を貼り付け、該半導体基板(11)の一面から前記リング状の補強部材(13)を除去し、該半導体基板(11)を各半導体素子を構成するチップ(22)にダイシングする、ようにしてもよい。

前記接着部材の層(14)は、前記第2のテープ状補強部材(18)の耐熱温度よりも低い融点を有し、前記第2のテープ状補強部材(18)の耐熱温度よりも低い温度の加熱によって前記接着部材の層(14)を溶融することにより、前記リング状の補強部材(13)を前記半導体基板(11)から除去する、ようにしてもよい。

10

前記第1の工程では、用意した半導体基板(11)の他面に、第1のテープ部材(11)を有機系接着剤で貼り付け、該半導体基板(11)の一面に、薄く加工することにより、該半導体基板(11)を所定の厚さにまで薄くし、前記第2の工程では、前記半導体基板(11)を、ヒータを備えるステージ(24)上に固定し、該ステージ(24)上に固定された前記半導体基板(11)を加熱することにより、前記第1のテープ状補強部材(12)が有する線膨張係数と該半導体基板(11)が有する線膨張係数との差によって該半導体基板(11)に生じた反りを緩和する、ようにしてもよい。

また、前記の課題を解決するため、本発明の第2の観点に係るリング補強部材は、所定の厚みに薄く加工された半導体基板(11)を備える半導体素子の製造工程に用いられ、中心に開口を有し、前記半導体基板(11)の外径と等しい外径を有するリング状の形状を有し、該半導体基板(11)の一面に接着部材によって固着されることにより、薄く加工することによって低下した該半導体基板(11)の強度を補う、ことを特徴とする。

20

このリング状補強部材は、例えば無機接着剤やポリイミド系樹脂から構成される接着部材によって半導体基板に固着されることにより、薄く加工することによって低下した半導体基板の強度を補う。また、リング状補強部材が例えば無機接着剤やポリイミド系樹脂によって半導体基板に固着されているので、半導体基板の一面または他面に電極を形成する処理条件下でガスが発生することがない。さらに、リング状補強部材が半導体基板と同一の外径を有するので、専用治具で半導体基板を保持する場合のように、専用治具に合わせて既存の搬送ユニット等を変更する必要がない。従って、製造ユニットを大幅に変更する必要がなく、製造コストの増大を招くことなく、薄く加工された半導体基板に割れや欠け

30

が発生することを防止することが可能となる。前記リング状補強部材は、薄く加工された前記半導体素子の所定の厚みよりも大きな厚みを有するものであってもよい。

前記リング状補強部材は、前記半導体基板(11)と同一の材料から構成され、該半導体基板(11)と等しい線膨張係数を有するものであってもよい。

【発明を実施するための最良の形態】

以下、本発明の実施の形態に係る半導体素子の製造方法及びこれに用いるリング状補強部材について、図面を参照して詳細に説明する。以下では、パワートランジスタを製造する場合を例にして説明する。

(第1の実施の形態)

40

この実施の形態の、半導体素子の製造方法及びこれに用いるリング状補強部材について、図1A~図1Gと図2を参照して説明する。

まず、図1Aに示すように、半導体基板(半導体ウェハ)11を用意する。半導体基板11は、例えば、単結晶シリコンから構成され、例えば厚さ500 μ m、直径15mm(6インチ)のサイズのほぼ円形の形状を有する。半導体基板11の一面の表面領域には、複数の半導体素子を形成するための複数の半導体領域(図示せず)が不純物拡散等によって形成されている。また、半導体基板11の一面には、スパッタリングや真空蒸着等によって金属膜(図示せず)が形成されている。この金属膜は、半導体素子の電極の一端、例えばパワートランジスタのエミッタ電極やベース電極を構成する。

次に、第1のテープ部材12を、紫外線硬化型接着剤、低粘着性接着剤、熱可逆性樹脂

50

等の有機系接着剤により半導体基板 1 1 の一面に固着させる。第 1 のテープ部材 1 2 は、耐熱性の高い樹脂、例えば、ポリエチレンテレフタレート樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリオレフィン樹脂から構成される。第 1 のテープ部材 1 2 は、半導体基板 1 1 の一面を保護するとともに、次の工程で半導体基板 1 1 を薄くする際に、半導体基板 1 1 に割れや欠けが発生することを防止するためのものである。

次に、バックグラインド（切削加工）やケミカルエッチングにより、図 1 B に示すように、半導体基板 1 1 の他面近傍部分（図の破線部分）を除去し、半導体基板 1 1 を薄くする。例えば、当所厚さ 500 μm の半導体基板を、100 μm の厚さにまで薄くする。半導体基板 1 1 は、その一面に貼り付けられた第 1 のテープ部材 1 2 によって補強されているので、薄く加工する時に発生する機械的ストレスによって割れや欠けが生じることが抑制または防止されている。

10

続いて、補強リング 1 3 を、図 1 C に示すように該半導体基板 1 1 の他面に固着させる。補強リング 1 3 は、例えば半導体基板 1 1 と同じ材料（例えば単結晶シリコン）から構成され、円板状のシリコン基板の中央部を円形に切削することによって形成されている。

図 2 に補強リング 1 3 が半導体基板 1 1 に固着している状態を示す。図示するように、補強リング 1 3 の外径は、半導体基板 1 1 の外径とほぼ同じに設定されている。補強リング 1 3 は、半導体基板 1 1 の外周縁に沿って貼り付けられている。この状態で、半導体基板 1 1 の他面が電極形成予定領域として補強リング 1 3 の中央部（円形に切削された部分）を介して露出する。補強リング 1 3 は、例えば、幅 5 ~ 7 mm、厚さ 400 ~ 900 μm 程度であって、半導体基板 1 1 に貼り付けられた状態で該半導体基板 1 1 の強度が十分に得られるとともに電極形成予定領域が十分に露出できるサイズ及び形状に構成されている。なお、望ましくは、補強リング 1 3 の厚さは、半導体基板 1 1 のうち、薄く加工された半導体基板 1 1 の厚さよりも大きい値に設定されているとよい。さらに好ましくは、補強リング 1 3 は、薄く加工された半導体基板 1 1 と補強リング 1 3 とを合わせた厚さが、薄くする前の半導体基板 1 1 とテープ部材 1 2 とを合わせた厚さとほぼ同じとなるように形成されているとよい。本実施の形態においては、半導体基板 1 1 は 400 μm 切削されており、補強リング 1 3 は 600 μm 程度の厚さを有する。

20

補強リング 1 3 は、無機接着材層 1 4 によって半導体基板 1 1 に固着されている。無機接着材層 1 4 は、例えば、半導体基板 1 1 を構成する材料、すなわちシリコンと良好な接着性を有する無機材料から構成されている。また、無機材料 1 4 は、第 1 のテープ部材 1 2 の耐熱温度よりも低く、後述するスパッタリングや真空蒸着工程を実行する温度（例えば 100 ~ 200 ）よりも高い融点を有する。

30

このような条件を満たす無機材料としては、例えば、インジウム（融点 156 . 6 ） 、スズ（融点 232 ） 、ビスマス（融点 271 . 4 ）等の金属あるいはこれらの合金等が挙げられる。スパッタリングや真空蒸着工程を実行する温度や第 1 のテープ部材 1 2 の耐熱温度に応じて使用する無機材料を選択する。

例えば、スズ 42 %、ビスマス 58 % から構成される合金の融点（液相温度）は 138 . 5 であり、鉛 44 . 5 %、ビスマス 45 . 5 % から構成される合金の融点（液相温度）は 124 、スズ 60 %、ビスマス 40 % から構成される合金の融点（液相温度）は 170 、インジウム 52 %、スズ 48 % から構成される合金の融点（液相温度）は 117 、インジウム 50 %、スズ 50 % から構成される合金の融点は 127 である。

40

以上のような無機接着材層 1 4 を用いた、補強リング 1 3 の半導体基板 1 1 への固着は、具体的には以下のようにして行うことができる。

まず、補強リング 1 3 の一面に、例えばメッキによって無機接着材層 1 4 を形成する。無機接着材層 1 4 は、半導体基板 1 1 と補強リング 1 3 とが十分に固着されるように、補強リング 1 3 の一面全体、あるいは点在するように設けられる。

次に、無機接着材層 1 4 が形成された補強リング 1 3 の一面を、半導体基板 1 1 の他面に重ねる。続いて、無機接着材層 1 4 が溶融する温度（無機接着材層 1 4 を構成する金属または合金の融点以上の温度）でこれらを加熱する。そして、これらを冷却することにより、無機接着材層 1 4 を硬化させ、補強リング 1 3 を半導体基板 1 1 に固着させる。

50

上述したように、無機接着材層 14 を構成する金属または合金の融点は、第 1 のテープ部材 12 の耐熱温度よりも低い。このため、無機接着材層 14 の加熱溶融の際に、第 1 のテープ部材 12 が熱によって劣化することは避けられる。

補強リング 13 の固着の後、図 1 D に示すように、半導体基板 11 の一面から第 1 のテープ部材 12 を剥離し、除去する。例えば、第 1 のテープ部材 12 を紫外線硬化性樹脂から構成される有機系接着剤によって半導体基板 11 に固着した場合は、接着剤に紫外線を照射する。これによって重合反応が生じて接着剤の接着力が低下するので、第 1 のテープ部材 12 を半導体基板 11 から容易に剥離することができる。

次に、半導体基板 11 の他面に金属膜（電極）を形成するため、半導体基板 11 を金属膜形成ユニットに搬送する。なお、搬送の際は、半導体基板 11 には補強リング 13 が固着されているために半導体基板 11 の強度は十分に確保され、割れや欠けの発生が抑制または防止されている。

また、上述したように、半導体基板 11（例えば、 $100\ \mu\text{m}$ ）と補強リング 13（例えば、 $600\ \mu\text{m}$ ）とを合わせた厚さは、薄くされる前の元の半導体基板 11 の厚さとほぼ同じである。このため、薄くされていない従来の半導体基板 11 を搬送するための、既存の搬送装置を用いて半導体基板 11 と補強リング 13 とを搬送することができる。

搬送に続いて、スパッタリングや真空蒸着等によって図 1 E に示すように、半導体基板 11 の他面に金属膜 15 を形成する。金属膜 15 は、例えば、チタン、ニッケル、金、白金等から構成されており、例えば $0.5\ \mu\text{m}$ の厚さで形成されている。この金属膜 15 は、例えばパワートランジスタのコレクタ電極を構成する。金属膜 15 は、半導体基板 11 の他面のみならず、補強リング 13 の上面にも形成される。

金属膜 15 を形成する際、半導体基板 11 の他面には、無機接着材層 14 によって補強リング 13 が固着されている。無機接着材層 14 は、上述したように、スパッタリングや真空蒸着等の処理温度よりも融点が高い金属または合金から構成されている。このため、無機系接着材層 14 は、有機系接着剤とは異なり、金属膜 15 を形成する条件下、例えば、処理温度 $100 \sim 200$ 、真空密度約 $10^{-5}\ \text{Pa}$ ($10^{-7}\ \text{Torr}$) では状態変化を起こさず、ガスを発生させない。

膜形成時に無機系接着材層 14 が熱によって溶融することがないので、半導体基板 11 は補強リング 13 に確実に保持された状態を維持することができる。

このように、補強リング 13 を、無機材料から構成される接着材で半導体基板 11 に固着することにより、悪影響がもたらされることなく、信頼性の高い金属膜 15 を形成することができる。

金属膜 15 を形成した後、必要に応じて、金属膜 15 をパターンニングし、電極を形成する。

続いて、半導体基板 11 を他の処理ユニットに搬送する。この搬送の際にも、半導体基板 11 は補強リング 13 によって補強され、また、補強リング 13 によって十分な厚みが付与されているので、薄く加工されていない従来の半導体基板 11 を搬送するための既存の搬送装置によって搬送可能である。

処理ユニットには、図 1 F に示すように、半導体基板 11 を載置するための凸型のステージ（サセプタ）16 が配置されている。ステージ 16 の凸部の上面は、補強リング 13 の内径よりも小径の平坦面に形成されている。この平坦面には、補強リング 13 が固着された面（他面）を下方に向けた半導体基板 11 が載置される。従って、半導体基板 11 の他面に形成された金属膜 15 と平坦面とは、互いに接する。

ステージ 16 の凸部のうち、少なくとも金属膜 15 に接する部分は、金属から構成されており、検査回路 30 に接続されている。検査回路 30 は、また、処理ユニットが備えるプローブ 17 に接続されている。プローブ 17 は、半導体基板 11 の一面に形成された電極に接触し、良品 / 不良品をインクマーキングやマッピング等によって区別する。

次に、図 1 G に示すように、半導体基板 11 の一面に、有機系接着剤（図示せず）を用いて第 2 のテープ部材 18 を貼り付ける。第 2 のテープ部材 18 は、第 1 のテープ部材 12 と同様に、無機接着材層 14 の融点よりも高い耐熱温度を有する樹脂材料から構成され

10

20

30

40

50

る。

続いて、半導体基板 1 1 を、一面に第 2 のテープ部材 1 8 が、他面に補強リング 1 3 がそれぞれ固着された状態で、無機接着材層 1 4 の融点温度以上の温度で加熱する。これにより、無機接着材層 1 4 が熔融し、図 1 H に示すように、補強リング 1 3 が半導体基板 1 1 から除去される。第 2 のテープ部材 1 8 の耐熱温度は、無機接着材層 1 4 の融点よりも高いので、補強リング 1 3 を除去する際に熱によって劣化することはない。

半導体基板 1 1 の一方の主面には第 2 のテープ部材 1 8 が貼着されているので、補強リング 1 3 が除去された後も半導体基板 1 1 の強度は十分に保持されている。なお、この状態では、半導体基板 1 1 の他面には、無機材料が残存付着している。

次に、図 1 I に示すように、半導体基板 1 1 の他面に、ダイシング用テープ 1 9 を貼り付ける。ダイシング用テープ 1 9 は、塩化ビニルやポリエステル等から構成される。ダイシング用テープ 1 9 は、その外周縁に配置されたリング状のキャリア部材 2 0 によって保持されている。

続いて、半導体基板 1 1 から第 2 のテープ部材 1 8 を除去する。紫外線硬化性接着剤で第 2 のテープ部材 1 8 を半導体基板 1 1 の一面に貼り付けた場合は、紫外線を照射することによって第 2 のテープ部材 1 8 を除去できる。

次に、図 1 J に示すように、ダイシング用テープ 1 9 がダイシングステージ 2 3 の上面に接するように半導体基板 1 1 をダイシングステージ 2 3 に載置する。ダイシングステージ 2 3 は、例えば、多孔質材料から構成されている。ダイシングステージ 2 3 に載置された半導体基板 1 1 は、ダイシングステージ 2 3 の下方から吸気することにより、ダイシングステージ 2 3 に固定される。

次に、半導体基板 1 1 をダイシング刃 2 1 でダイシングする。これによって半導体基板 1 1 から個々の半導体素子（ダイ）2 2 を分離する。半導体基板 1 1 には、例えば紫外線硬化性接着剤でダイシング用テープ 1 9 が貼り付けられているので、各ダイ 2 2 からダイシング用テープ 1 9 を剥離するため、紫外線を照射する。そして、コレットと呼ばれる吸引治具によって各ダイ 2 2 をピックアップし、ダイボンディング等の次の工程を実行するためのユニットに搬送する。

以上のように、本実施の形態では、比較的薄い半導体基板 1 1 を用いた半導体素子の製造方法において、金属または合金から構成される無機接着材層 1 4 により、シリコンから構成される補強リング 1 3 を半導体基板 1 1 に固着して金属膜 1 5 を形成している。

上記のような構成の補強リング 1 3 及び無機接着材層 1 4 を用いることにより、補強のためにテープ部材を有機系接着剤で半導体基板 1 1 に固着することなく、スパッタリングや真空蒸着等によって電極を形成することができる。これにより、有機系接着剤からのガスの発生等がない状態で電極（金属膜 1 5）を形成することが可能となるので、信頼性の高い半導体素子を製造することができる。また、膜形成の際に、無機接着材層 1 4 が熔融することなく、薄く加工された半導体基板 1 1 が補強リング 1 3 によって保持された状態を維持することが可能である。このため、半導体基板 1 1 に割れや欠けが発生することが防止される。

また、無機接着材層 1 4 は、第 1 のテープ部材 1 2 の耐熱温度よりも低い融点を有する金属または合金から構成されている。このため、半導体基板 1 1 に第 1 のテープ部材 1 2 を貼り付けた状態でこれを劣化させることなく、無機接着材層 1 4 を熔融させて補強リング 1 3 を半導体基板 1 1 に固着させることができる。

さらに、薄く加工された半導体基板 1 1 と補強リング 1 3 とを合わせた厚さが、薄く加工される前の元の半導体素子の厚さとほぼ等しい。このため、既存の製造ユニットをそのまま使用することができる。従って、本実施の形態の補強リング 1 3 を用いることにより、製造コストを大幅に増大させることなく、薄い半導体基板 1 1 に割れや欠けが発生することを防止できる。

（第 2 の実施の形態）

この実施の形態では、補強リング 1 3 を、無機接着材層 1 4 の代わりにポリイミド系樹脂等から構成される耐熱性樹脂によって半導体基板 1 1 に固着する場合の半導体素子の製

10

20

30

40

50

造方法について説明する。以下、この実施の形態の半導体素子の製造方法を図3A～図3Gを参照して説明する。

まず、半導体基板11を用意する。この半導体基板11は、第1の実施の形態と同様に、複数の半導体素子が形成されている。また、半導体基板11の一面には、電極が形成されている。

次に、半導体基板11の一面に、例えば紫外線硬化型接着剤を介して第1のテープ部材12を貼り付け、半導体基板11を薄くする。本実施の形態においても、例えば当初厚さ500 μ mの半導体基板11を厚さ100 μ mにまで薄くした。

続いて、半導体基板11を、図3Aに示すように、第1のテープ部材12が貼り付けられた他面を上にして、吸着ステージ24上に載置する。吸着ステージ24は、例えば多孔質材料から構成されている。半導体基板11は、吸着ステージ24の下方からの吸気によって吸着ステージ24上に固定される。

吸着ステージ24は、ヒータ31を備えており、吸着面(半導体基板11が載置された面)を室温よりも5～70程度高い温度にし、半導体基板11を加熱する。吸着ステージ24は、載置された半導体基板11を室温よりも数十高い温度(例えば、40～70)に加熱する。

第1のテープ部材12が貼り付けられた半導体基板11には、半導体基板11と第1のテープ部材12との線膨張係数の差によって反りが生じている場合がある。この反りは、吸着ステージ24による加熱によって緩和される。

より詳細に説明すると、第1のテープ部材12は、半導体基板11が所定の温度に加熱された状態で該半導体基板11の一面に貼り付けられる。このため、半導体基板11の温度が低下すると、線膨張係数の差によって半導体基板11に反りが生じる場合がある。そこで、第1のテープ部材12が貼り付けられた半導体基板11を吸着ステージ24上で再度加熱することにより、線膨張係数の差によって生じた反りを緩和させる。これにより、後続する種々の工程での処理を、高い精度で実行することができる。

次に、吸着ステージ24に固定された半導体基板11から、第1のテープ部材12を除去する。

続いて第1の実施の形態と同様の補強リング13を用意し、図3Cに示すように、耐熱性接着材層25を介して半導体基板11に固着する。

耐熱性接着材層25は、例えば、ポリイミド系樹脂から構成されている。耐熱性接着材層25は、後述するスパッタリングや真空蒸着工程を実行する温度(例えば、100～200)よりも高い融点または軟化点を有する。

この耐熱性接着材層25を用いた補強リング13の半導体基板11への固着は、具体的には以下のようにして実行することができる。

まず、補強リング13の一面に、例えば溶解または軟化させた耐熱性接着材を塗布することにより、耐熱性接着材層25を形成する。

次いで、補強リング13の一面と半導体基板11の一面とが対向するように、補強リング13を半導体基板11に載置する。半導体基板11、補強リング13、耐熱性接着材層25等を後述するスパッタリングや真空蒸着工程を実行する温度よりも高い温度で加熱し、耐熱性接着材層25を再び溶解または軟化させる。

そして、半導体基板11、補強リング13、耐熱性接着材層25等を冷却することにより、補強リング13を半導体基板11に固着させる。

補強リング13の固着は、第1のテープ部材12を半導体基板11から剥離した後に行われている。しかし、半導体基板11は吸着ステージ24に固定されているので半導体基板11の強度は十分に確保されている。これにより、補強リング13を固着する際に半導体基板11に割れや欠けが発生することが抑制または防止されている。

補強リング13の固着後、金属膜を形成するための金属膜形成ユニットに半導体基板11を搬送する。搬送の際、半導体基板11には補強リング13が固着されているので、半導体基板11の強度は十分に確保され、割れや欠けの発生は抑制または防止される。

半導体基板11と補強リング13とを合わせた厚さは、薄く加工されていない半導体基

板 1 1 の厚さとほぼ同じである。このため、薄く加工されていない従来の半導体基板 1 1 を搬送するための、既存の搬送装置で半導体基板 1 1 と補強リング 1 3 とを搬送することができる。

金属膜形成ユニットに半導体基板 1 1 を搬送した後、スパッタリングや真空蒸着等により、図 3 D に示すように、半導体基板 1 1 の他面に金属膜 1 5 を形成する。金属膜 1 5 は、例えば、チタン、ニッケル、金、白金等から構成され、例えば、 $0.5 \mu\text{m}$ の厚さで形成されている。

金属膜 1 5 を形成する際、半導体基板 1 1 には、ポリイミド系樹脂から構成された耐熱性接着材層 2 5 によって補強リング 1 3 が固着されている。上述したように、耐熱性接着材層 2 5 は、スパッタリングや真空蒸着工程を実行する温度よりも高い融点または軟化点を有するので、電極形成の条件下、処理温度 $100 \sim 200$ 、真空度約 10^{-5} Pa (10^{-7} Torr) で分解等によってガスが発生しない。

このように、ポリイミド系樹脂から構成される接着材で補強リング 1 3 を半導体基板 1 1 に固着することにより、悪影響がもたらされることなく金属膜 1 5 を形成することができる。

金属膜 1 5 を形成した後、必要に応じて金属膜 1 5 をパターニングし、例えばパワートランジスタのコレクタ電極を形成する。

続いて、半導体基板 1 1 を他の処理ユニットに搬送する。この搬送の際も、補強リング 1 3 によって安定に保持された状態の半導体基板 1 1 を、既存の搬送装置で搬送することができる。

処理ユニットには、図 3 E に示すように、平坦な平面を有するステージ 2 6 が配置されている。搬送された半導体基板 1 1 は、ステージ 2 6 の平坦面に載置される。図示するように、半導体基板 1 1 は、補強リング 1 3 が取り付けられた面を上向きにしてステージ 2 6 に載置されるので、ステージ 2 6 は、第 1 の実施の形態のステージ 1 6 のように凸型である必要はない。

ステージ 2 6 の、少なくとも半導体基板 1 1 に接する部分は、金属から構成され、検査回路 3 0 に接続されている。この検査回路 3 0 は、処理ユニットに設けられたプローブ 2 7 にも接続されている。プローブ 2 7 により、第 1 の実施の形態と同様に検査が行われる。

検査の後、第 1 の実施の形態と同様にして、図 3 F に示すように、半導体基板 1 1 の他面にダイシング用テープ 1 9 が貼り付けられる。ダイシング用テープ 1 9 は、塩化ビニルやポリエステル等から構成されており、その外周縁に沿って配されたリング状のキャリア部材 2 0 によって保持されている。

次に、図 3 G に示すように、ダイシングステージ 2 3 に、半導体基板 1 1 を載置する。より詳細には、半導体基板 1 1 の他面に貼り付けられたダイシング用テープ 1 9 がダイシングステージ 2 3 の上面に接するように半導体基板 1 1 をダイシングステージ 2 3 に載置する。ダイシングステージ 2 3 に載置された半導体基板 1 1 は、第 1 の実施の形態と同様に、例えばダイシングステージ 2 3 の下方からの吸気によって、ダイシングステージ 2 3 の上面に固定する。

そして、第 1 の実施の形態と同様に、ダイシングステージ 2 3 に固定された状態で、半導体基板 1 1 をダイシング刃 2 1 でダイシングする。

ダイシングによって分離された個々の半導体素子 (ダイ) 2 2 から、第 1 の実施の形態と同様にダイシング用テープ 1 9 を剥離する。そして、コレットと呼ばれる吸引治具で各ダイ 2 2 をピックアップし、次の処理 (例えばダイボンディング) を行うためのユニットに搬送する。

なお、補強リング 1 3 が固着された部分の半導体基板 1 1 は、ダイ 2 2 として使用されないため、補強リング 1 3 が固着されたままの状態でも除去される。

以上のように、補強リング 1 3 を半導体基板 1 1 に固着させるためにポリイミド系樹脂等から構成される耐熱性接着材層 2 5 を用いても、第 1 の実施の形態と同様の効果を得ることができる。

10

20

30

40

50

また、本実施の形態の製造方法では、半導体基板 1 1 から第 1 のテープ部材 1 2 を剥離した後に、補強リング 1 3 を半導体基板 1 1 に固着している。このため、補強リング 1 3 を固着する際に、第 1 のテープ部材 1 2 の耐熱性を考慮する必要がない。この結果、第 1 のテープ部材 1 2 として使用できる材料の自由度が、第 1 の実施の形態よりも大きくなるので、コスト削減等が可能となる。

さらに、本実施の形態の製造方法では、薄く加工した半導体基板 1 1 を加熱しているので、半導体基板 1 1 と第 1 のテープ部材 1 2 の線膨張係数の差によって生じた反りを緩和することができる。

本実施の形態の製造方法によれば、第 1 の実施の形態の製造方法よりもテープ部材の張り替え工程が少なく、より高い生産性を実現できる。

なお、第 1 及び第 2 の実施の形態の製造方法は、コンピュータがプログラムに基づいて搬送ユニットや半導体処理ユニット等を制御することによって実行することができる。

本発明は上記実施の形態に限定されない。例えば、第 1 及び第 2 の実施の形態の製造方法を適宜組み合わせてもよい。例えば、第 1 の実施の形態において無機接着材層 1 4 の代わりに耐熱性接着材層 2 5 を用いてもよいし、第 2 の実施の形態において耐熱性接着材層 2 5 の代わりに無機接着材層 1 4 を用いてもよい。

第 1 及び第 2 の実施の形態では、補強リング 1 3 が、半導体基板 1 1 と同一の材料から構成される場合を例にして説明した。このような構成を採用することにより、半導体基板 1 1 と補強リング 1 3 との線膨張係数を同じにすることができ、線膨張係数差に起因する歪み等の発生を低減または防止できる。しかし、線膨張係数差に起因する歪み等の発生を低減または防止できる限り、補強リング 1 3 は他の材料から構成されてもよい。

第 1 及び第 2 の実施の形態では、半導体基板 1 1 が、シリコン単結晶基板から構成される場合を例にした。しかし、半導体基板 1 1 は、インジウム - リンやシリコンカーバイド等の化合物半導体等から構成されてもよい。

第 1 及び第 2 の実施の形態では、パワー系の半導体素子を製造する場合を例にした。しかし、これに限定されず、比較的薄い半導体基板を用いた他の種の半導体素子を製造してもよい。

なお、本発明は、2002年6月25日に出願された日本国特許出願2002-183939号及び2002年11月1日出願された日本国特許出願2002-319884号に基づき、本明細書中にその明細書、特許請求の範囲、図面全体を取り込むものとする。

【産業上の利用の可能性】

本発明は、比較的薄い半導体基板を備えた半導体素子の製造方法に利用可能である。

【図面の簡単な説明】

図 1 A ~ 図 1 J は、本発明の第 1 の実施の形態に係る半導体素子の製造方法を説明するための側面図である。

図 2 は、半導体基板に補強リングが固着された状態を示す斜視図である。

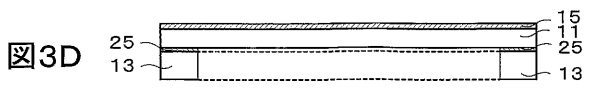
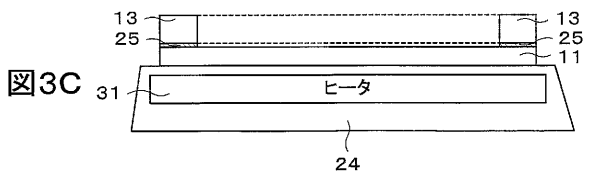
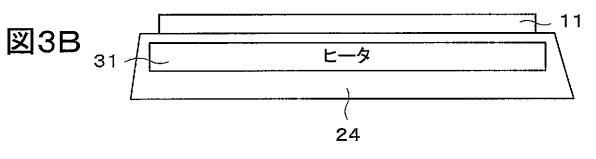
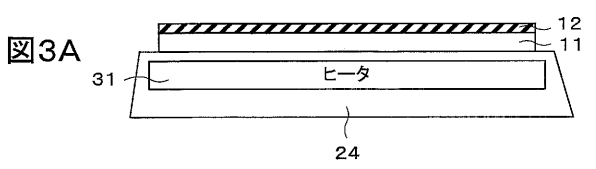
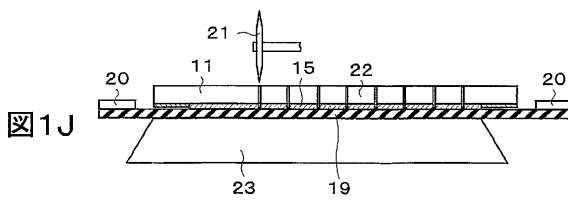
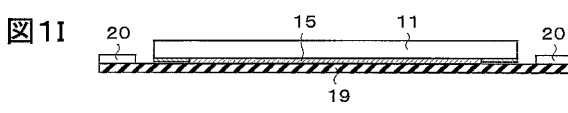
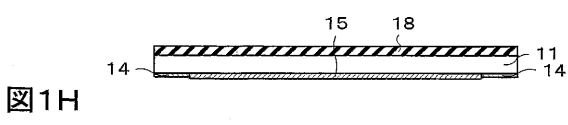
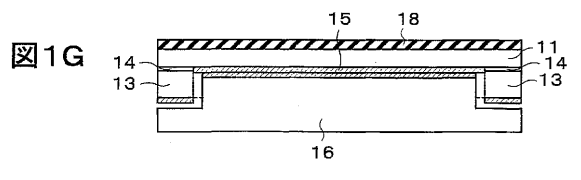
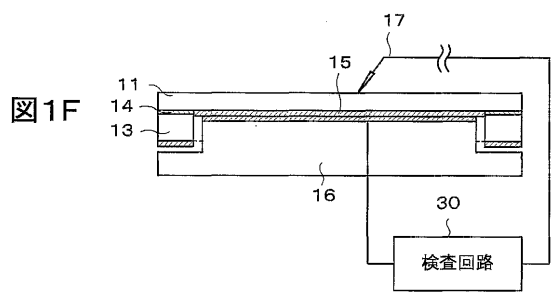
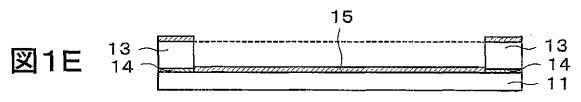
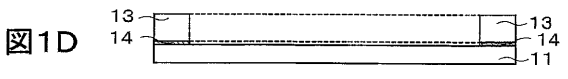
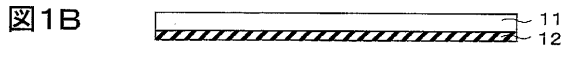
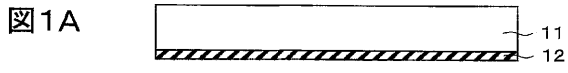
図 3 A ~ 図 3 G は、本発明の第 2 の実施の形態に係る半導体素子の製造方法を説明するための側面図である。

図 4 A ~ 図 4 E は、従来の半導体素子の製造方法を説明するための側面図である。

10

20

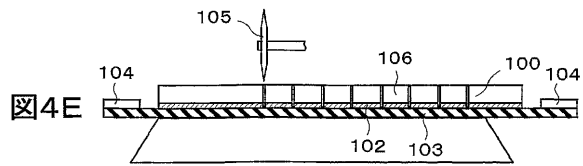
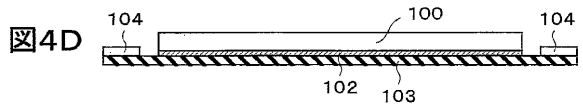
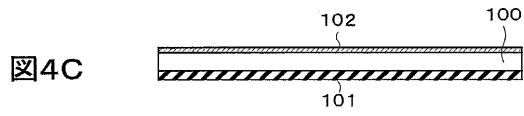
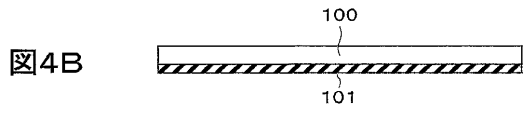
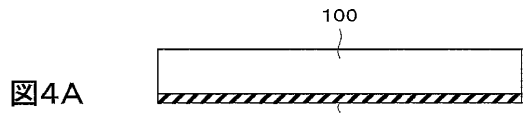
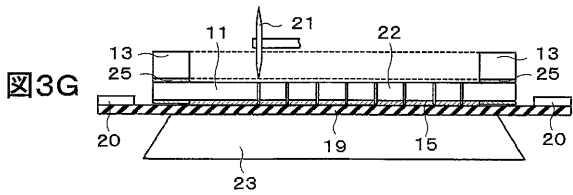
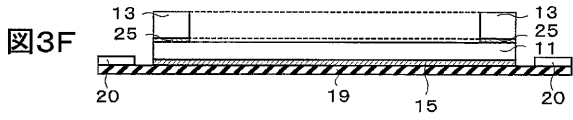
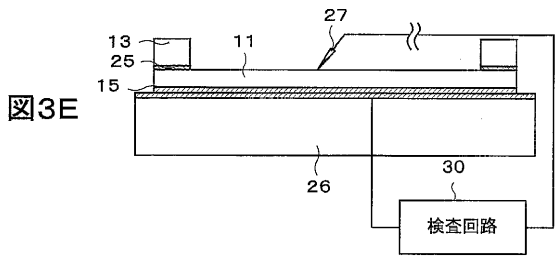
30



【 図 2 】



図2



【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/07975

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ H01L21/02, H01L21/304		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ H01L21/02, H01L21/304		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2003 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2003 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2003		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A X	JP 2002-100589 A (Hitachi, Ltd.), 05 April, 2002 (05.04.02), Full text; Figs. 1 to 16 Page 7, left column, line 45 to right column, line 47; Figs. 14 to 16 (Family: none)	1-10 11-13
A	JP 2000-12492 A (Motorola Japan Ltd.), 14 January, 2000 (14.01.00), Full text; Figs. 1 to 5 (Family: none)	1-13
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	"J" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family	
Date of the actual completion of the international search 18 September, 2003 (18.09.03)	Date of mailing of the international search report 30 September, 2003 (30.09.03)	
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Authorized officer	
Facsimile No.	Telephone No.	

国際調査報告		国際出願番号 PCT/JP03/07975
A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))		
Int. Cl ⁷ H01L21/02, H01L21/304		
B. 調査を行った分野		
調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))		
Int. Cl ⁷ H01L21/02, H01L21/304		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの		
日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2003年 日本国登録実用新案公報 1994-2003年 日本国実用新案登録公報 1996-2003年		
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)		
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A X	JP 2002-100589 A (株式会社日立製作所) 2002.04.05, 全文, 第1-16図, 第7頁左欄45行~同頁右欄47行, 第14-16図 (ファミリーなし)	1-10 11-13
A	JP 2000-12492 A (モトローラ株式会社) 2000.01.14, 全文, 第1-5図 (ファミリーなし)	1-13
<input type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。		<input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。
* 引用文献のカテゴリー		の日の後に公表された文献
「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの		「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの		「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)		「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献		「&」 同一パテントファミリー文献
「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願		
国際調査を完了した日	18.09.03	国際調査報告の発送日
		30.09.03
国際調査機関の名称及びあて先	特許庁審査官 (権限のある職員)	4L 9170
日本国特許庁 (ISA/JP)	大嶋 洋一	
郵便番号100-8915		
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 6764

(注)この公表は、国際事務局(WIPO)により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願(日本語実用新案登録出願)の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。